

Cesto De Limpeza Personalizado Para Wafer De Semicondutor Em Ptfе - Suporte De Laboratório Resistente À Corrosão Com Baixo Nível De Impurezas

Número do item: PL-CP267



introdução

Alcance pureza superior na fabricação de semicondutores com nossos cestos de limpeza personalizados em PTFE. Projetados para resistência química extrema e baixa interferência de fundo, esses suportes duráveis garantem processamento eficiente de wafers, drenagem rápida e desempenho confiável em ambientes de laboratório críticos de alta pureza.

[Saiba mais](#)

Aplicação	Descrição	Benefício Principal
Processo de Limpeza RCA	Usado durante as sequências SC-1 e SC-2 para remover resíduos orgânicos e contaminantes metálicos de wafers de silício.	Evita a recontaminação graças à superfície do material ultrapura e de baixa lixiviação.
Ataque Piranha	Manuseio de wafers em uma mistura de ácido sulfúrico e peróxido de hidrogênio para remoção de fotorresiste.	Resistência excepcional a ambientes oxidantes agressivos sem degradação estrutural.
Imersão em Ácido Fluorídrico	Remoção de camadas de óxido nativo de substratos de silício usando soluções de HF concentradas ou tamponadas.	Imunidade total ao ataque de HF, garantindo longa vida útil do equipamento e pureza do processo.
Enxágue Pós-CMP	Limpeza de wafers após Polimento Mecânico-Químico para remover partículas de pasta de polimento e produtos químicos.	A drenagem rápida e as propriedades antiaderentes evitam que partículas de pasta adiram ao cesto.
Desenvolvimento de Fotolitografia	Suporte a substratos durante o desenvolvimento e remoção de camadas de fotorresiste.	A alta estabilidade dimensional garante alinhamento e manuseio precisos durante as etapas críticas de litografia.
Preparação para Análise de Traços	Limpeza de vidrarias e recipientes usados em ICP-MS e outras técnicas analíticas de alta sensibilidade.	Níveis de fundo extremamente baixos garantem a maior precisão na detecção de impurezas metálicas traço.
Processamento de Wafer de GaAs	Manuseio de wafers de semicondutor composto através de ciclos especializados de ataque e enxágue.	Estruturas de suporte delicadas evitam a quebra de materiais de semicondutor composto frágeis.
Limpeza Ultrasônica	Funciona como um suporte submerso durante ciclos de limpeza acústica de alta frequência.	Transmite eficientemente a energia ultrassônica enquanto protege os wafers do contato mecânico com o tanque.

Característica	Detalhes da Especificação para PL-CP267
Identificador do Modelo	PL-CP267
Material Principal	PTFE Virgem de Alta Pureza (Politetrafluoroetileno)
Processo de Fabricação	100% Usinagem CNC de Precisão (Sem resíduos de moldagem por injeção)
Resistência Química	Resistência total a HF, H2SO4, HNO3, HCl, KOH e Solventes Orgânicos
Faixa de Temperatura	-200°C a +260°C (-328°F a +500°F)
Acabamento de Superfície	Acabamento liso e de baixa porosidade para minimizar a retenção de partículas
Opções de Configuração	Totalmente Personalizável (Tamanho de wafer, largura de ranhura, espaçamento de ranhura, design de alça)

Aplicação	Descrição	Benefício Principal
Característica	Detalhes da Especificação para PL-CP267	
Compatibilidade com Wafer	Adequado para wafers de 2", 3", 4", 6", 8" e 12" ou dimensões personalizadas	
Design de Drenagem	Perfis de ranhura com fundo em V ou U disponíveis para escoamento de fluido otimizado	
Níveis de Impurezas	Processado especificamente para requisitos de impurezas metálicas sub-ppb	